

1.8

Semiconductores Extrínsecos

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO



FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Nombre de la materia: Electrónica Analógica I Clave: CI0100-T No. de horas/semana: 3 Total de horas: 48 No. de créditos: **Prerrequisitos:** Álgebra Superior (CB0200-T) Objetivo general: Que el alumno adquiera los conceptos básicos de la teoría de los semiconductores y de la teoría de los circuitos para el analisis y diseño de circuitos electronicos basicos con los dispositivos fundamentales de la electronica de estado solido, como son los diodos, y los transistores bipolares o BJT"s. Contribución a los atributos de egreso y su nivel de aportación • AE1. Aplicar los conocimientos de ingeniería adquiridos durante sus estudios para elaborar (Inicial) proyectos de ingeniería que resuelvan problemas específicos. • AE2. Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería mediante un pensamiento crítico y (Inicial) asertivo, basados en los principios de ciencias básicas e ingeniería. Programa sintético 1. Introducción a la física de los semiconductores (Horas) ______4 hrs. 2. Introducción a la Teoría de Circuitos. (0 Horas) ______10 hrs. 3. Características del Diodo Unión. (Horas) 4 hrs. 4. Dispositivos Semiconductores de dos Terminales y Circuitos de Aplicación. (Horas) 6 hrs. 5. El Transistor Bipolar (BJT). (Horas) 4 hrs. 6. Análisis y Diseño de Circuitos Amplificadores con BJT. (8 Horas) ______7 hrs. 7. Análisis de Amplificadores de pequeña señal. _____7 hrs. Total: 42 hrs. Programa desarrollado 1. Introducción a la física de los semiconductores (Horas) 4 hrs. 1.1 Clasificación de los materiales. 1.2 conductores 1.3 aislantes o dieléctricos 1.4 semiconductores (Si y Ge) 1.5 Construcción de los semiconductores. Redes cristalinas 1.7 Semiconductor intrínseco.



UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO



FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

1.9	Dopado			
1.10	•			
	Tipo P.			
	Características eléctricas.			
2. Introdu	ucción a la Teoría de Circuitos. (0 Horas)10 hrs.			
2.1	Conceptos Básicos			
2.2	Carga, corriente, potencial y fuerza electromotriz			
2.3	resistencia y circuitos resistivos			
2.4	Capacitores y circuitos con capacitores			
2.5	Impedancia			
2.6	Ley de ohm			
2.7	Fuentes de CD y CA			
2.8	Valores Característicos de las señales de voltaje y corriente			
2.9	Fuentes dependientes y no dependientes de voltaje y corriente			
2.10	Leyes de Kirchoff			
2.11	Ley de Voltaje de Kirchoff (LKV)			
2.12	Ley de Corriente de Kirchoff (LCV)			
2.13	Teoremas de Thevenin y Norton			
2.14	Teorema de Thevenin			
2.15	Teorema de Norton			
2.16	Equivalencias			
2.17	Teorema de superposición.			
2.18	Primer examen parcial			
3. Caract	terísticas del Diodo Unión. (Horas)4 hrs.			
3.1	Unión semiconductora NP o PN, construcción de la unión, zonas de la unión.			
3.2	Conceptos de polarización.			
3.3	Características eléctricas de la unión, (RCD RCA Voltaje Unión V.I.P., etc)			
4. Dispositivos Semiconductores de dos Terminales y Circuitos de Aplicación. (Horas) 6 hrs.				
4.1	Rectificador media onda y onda completa.			
4.2	Diodo Zener			
4.3	Diodo LED			
4.4	Celda fotovoltaica y fotodiodo			
4.5	Otros diodos			
5. El Trai	nsistor Bipolar (BJT). (Horas)4 hrs.			
5.1	Construcción del BJT			
5.2	Tipos de BJT y funcionamiento			
5.3	Características eléctricas del BJT			
5.4	Configuraciones Básicas			
6. Anális	is y Diseño de Circuitos Amplificadores con BJT. (8 Horas)7 hrs.			



UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO



FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

6.1	Emisor común		
6.2	Colector común		
6.3	Base común		
6.4	Transistor BJT en conmutación.		
6.5	Segundo examen parcial		
7. Anális	sis de Amplificadores de pequeña señal.	7 hrs	3.
7.1	Parámetros Híbridos.		
7.2	Descripción matemática		
7.3	Parámetros reducidos		
7.4	Impedancia de entrada, Impedancia de salid	a, ganancia de voltaje	
7.5	Modelo re y equivalencia con híbridos		
7.6	Aplicación a los circuitos de amplificadores		
7.7	Tercer examen parcial		

Bibliografía básica:

1.-Electrónica Teoría de Circuios Boylestad-Nashelky rentice-Hall

Bibliografía complementaria:

- 1.-Principios de Electrónica 3a Ed.
- A. P. Malvino McGraw-Hill
- 2.-Diseño Electrónico 2a ED.
- C. J. Savant Jr.

Addison-Wesley Iberoamericana

- 3.-Electronics Devices and Circuits 2a Ed.
- Theodore F. Bogart Jr.

Maxwell Macmillan

- 4.-Circuitos y Dispositivos Electrónicos
- R. J. Tocci

Interamericana

5.-Electrónica Integrada

Millman-Halkins

McGraw-Hill

6.-Electronic Devices and Circuits

David A. Bell

Reston

7.-Circuitos Electrónicos Discretos e Integrados



UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO



FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

M. S. Ghausi

8.-Dispositivos y Circuitos ElectrónicosY. N. BapatInteramericana McGraw-Hill

9.-Manual de Semiconductores Texas Instrument Manuales de sustitución de los Fabricantes: Dicopel, SK, ECG, NTE, GE

Metodologías de enseñanza-aprendizaje:

 Revisión de conceptos, análisis y solución de problemas en clase 	(X)
Lectura de material fuera de clase	(X)
Ejercicios fuera de clase (tareas)	(X)
Investigación documental	(X)
 Elaboración de reportes técnicos o proyectos 	(X)
Prácticas de laboratorio en una materia asociada	(X)

Metodologías de evaluación:

Tareas	(X)
Elaboracion de reportes técnicos o proyectos	(X)
Exámenes de academia o departamentales	(X)

Revisores:

Ignacio Franco Torres Víctor Quintero Rojas Juan Pedro Duarte Víctor Barbosa García José Luis González Ávalos